

[PRESS RELEASE]

2009年8月27日

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー

富士通マイクロエレクトロニクスと TSMC、28nm 世代での製造および開発で協力

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:岡田晴基、本社:東京都新宿区、以下、富士通マイクロエレクトロニクス)と台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(会長 兼 CEO:モリス・チャン、本社:台湾新竹、以下、TSMC)は 28 ナノメートル(以下、nm)世代ロジック IC の製造と半導体プロセステクノロジーの開発で協力します。

両社は、すでに富士通マイクロエレクトロニクスが 40nm 世代ロジック IC の製造を TSMC へ委託することで合意しています。今回、新たに 28nm 世代についても製造を委託し、さらに、製造に先がけて TSMC の先進テクノロジープラットフォームを活用した 28nm 世代の高性能プロセステクノロジーを共同開発することでも合意しました。28nm 世代製品において最初のサンプル出荷は、2010 年末を予定しています。

富士通マイクロエレクトロニクスは処理速度の高速化を実現する先端プロセステクノロジーおよび低消費電力化を実現するデザインテクノロジーを保有し、TSMC は電力効率の高い高性能ロジックおよび SoC プロセスおよび Open Innovation Platform™(注 1)の一部である先端テクノロジープラットフォームを保有します。両社はこれらの強みを結びつけることによって、28nm 世代のロジック IC においても高性能および低消費電力製品を含む TSMC の 28nm テクノロジーポートフォリオをベースとした競争力のある高性能 28nm 世代テクノロジーを活用できます。

また両社は、協力関係による一層の顧客価値創造を目指し、富士通マイクロエレクトロニクスが強みとする、鉛フリー材料や超多ピン高密度パッケージと、TSMC が強みとするチップ・パッケージ集積技術や先進的な銅・ELK(注2)を活かした両社の先進的なパッケージ技術の共同開発を視野に入れた協議も進めております。

富士通マイクロエレクトロニクスの執行役員常務 八木春良は、次のようにコメントしています。「発表済の 40nm 世代テクノロジーにおける TSMC とのパートナーシップも順調に進んでおり、現在複数の商品設計を進めております。今回 28nm 世代における製造、28nm 世代高性能テクノロジーの共同開発にも合意したことで、両社の強みを融合した先進の顧客価値の提供を拡大し、TSMC のビジネス、および当社が注力する ASIC、ASSP ビジネスにおいて、さらなる成長が可能になるものと考えます。」

TSMC の副社長で Worldwide Sales and Marketing 担当のジェイソン・チェンは、次のようにコメントしています。「富士通マイクロエレクトロニクスは、先進テクノロジーの開発と立ち上げに関する卓越した経歴にもとづいて、TSMC をパートナーに選びました。TSMC のテクノロジープラットフォームはデザインキットやデザインフロー、TSMC やサードパーティの IP といった設計に関する配慮、ロバストなデバイスに関するドキュメントやプロセステクノロジーの秀逸性、および後工程の組み立ておよび試験能力で構成されます。今回の合意は、そのテクノロジープラットフォームに対する支持表明でもあります。」

【注釈】

注1 Open Innovation Platform :TSMCが推進するOpen Innovation Platform™は、半導体設計コミュニティ、TSMCのエコシステム・パートナーとTSMCのIP、設計実装及びDFM機能、プロセス技術及びバックエンド・サービスにおいて、効率的に且つ敏速な技術革新の促進を目指すものです。

注 2 ELK：超低誘電率(ELK: extreme Low-k)の層間絶縁膜。

【関連リンク】

<http://jp.fujitsu.com/microelectronics/>(富士通マイクロエレクトロニクス)

【報道機関お問い合わせ先】

富士通株式会社

電話:03-6252-2174(直通)

TSMC ジャパン株式会社

プレスセンター

株式会社イーアンドイー内

電話:0422-30-8800